

Effect Of Well-Thickness On The Performance Of Lattice-Matched Multiple Quantum Well Lasers

Haider M. Alsabbagh*

Received On 10/7/1997

Accepted On 14/1/1998

Abstract

A theoretical investigation is concerned to discuss influence of well thickness on the performance of matched multi-quantum well lasers, operating at (1.3-1.5) μm , depending on the well width. Transition of carriers from conduction to valence band and their transport through epitaxial layers are discussed. Calculations for the gain are performed taking into account details of energy subbands, state of polarization and impact of intervalence band absorption. Threshold current density (J_{th}) for quantum well structure is studied. An optimization for threshold current density is made by optimizing the number of quantum wells for a specific well size. It has been found that there is a range of optimum values for well thickness that yields an optimum value of J_{th} .

الخلاصة

يتناول هذا البحث دراسة نظرية لتأثيرات ابعاد بئر الكم في أداء ليزرات متعددة الأبار الكمومية ذات الأبعاد البلورية المتجانسة ومصنعة من مادة GaInAs/GaInAsF، تعمل على أطوال الموجة (1.3-1.5) μm (اعتماداً على عرض البئر) المستخدمة في الاتصالات الضوئية والكثرونيونية. حيث تم مناقشة انتقال الحاملات من حزمة التوصيل إلى حزمة التكافؤ وعمور العمليات خلال الضغوط المترتبة على تركيب البنية التحليلات التي أجريت لحساب الكسب أخذت بالحظر الانتشار تفاصيل الحزم العنقودية إضافة إلى استقطاب الضوء والامتصاص الذي يحدث في حزمة التكافؤ. كذلك تم دراسة كثافة التيار عند حد القطع وتم التوصل إلى القيمة المثلى لكثافة التيار عند هذا الحد وذلك بالحصول على لعدد الأمثل لعند الألو الكهوية التي تتناول كل قيمة مستخدمة لعرض البئر الكمومي. وقد وجد أن هناك مجال نسبياً لبعض القيم لعرض البئر التي تقابل القيمة المثلى لكثافة التيار عند حد القطع.

Symbol	Physical Quantity	Values
A	Auger recombination coefficient	$3 \times 10^{11} \text{m}^6 \text{Sec}^{-1}$
J_{th}	Current density at threshold	
K_0	Intervalence - band absorption	$4 \times 10^{22} \text{cm}^{-2}$
L	Laser length	250 μm
L_p	Width of potential barrier	100 Å
N	Carrier density	
N_q	Number of quantum wells	
R	Reflectivity laser mirror	0.32
R_{nr}	Nonradiative recombination coefficient	10^5sec^{-1}
R_r	Radiative recombination coefficient	$1 \times 10^{21} \text{m}^3 \text{sec}^{-1}$
α_i	Absorption loss	30 cm^{-1}

* Dept. of Electrical Eng.-College of Eng. University of Basrah.